

The 78th JSAP Autumn Meeting 2017

会期 2017年9月5日(火)~8日(金)

会場 福岡国際会議場

登壇申込締切：2017年6月27日(火)17:00(厳守)

URL：<https://meeting.jsap.or.jp/entry>

- 公募シンポジウム申請締切：2017年4月14日(金)
- 分科企画シンポジウム申請締切：2017年5月12日(金)
- 会合(IM)申込締切：2017年7月下旬

大会ページ



ご注意

- 登壇申込締切以後の登録内容の修正、予稿の差し替え、申込の取消はいたしかねます。
- ご提出いただいた予稿の著作権は応用物理学会に帰属します。
- JSAP-OSAジョイントシンポジウムに投稿された予稿は、OSA Optics InfoBaseにも収録されます。
- 発表形式(口頭・ポスター)はご希望に添えない場合があります。その際、登壇者の方への事前の連絡はいたしかねますのでご了承下さい。
- 登壇申込締切後のプログラム編集委員会において、複数中分類合同で行うコードシェアセッションの実施を決定することがあります。このため、ご投稿時に希望された中分類ではなく、他の中分類とのコードシェアセッションに講演がプログラムされる場合があります。
- プログラム編集時に、発表を希望した中分類から他の中分類やシンポジウムへ、またはシンポジウムから他の中分類へ移動する場合があります。
- 一般講演における会員1人あたりの登壇件数は口頭講演とポスター講演をあわせて原則3件です。
- 応用物理学(広義の)に関する内容以外を含むもの、応用物理学から著しく逸脱するもの、あるいは本会の品位と信用を損なう恐れがあるものと判断される講演申込は受理しません。

一般講演で登壇するための3つのステップ

1. 入会登録

※※非会員のみ※※

一般会員

入会金 10,000円
年会費 10,000円

大学生・大学院生

入会金 3,000円
年会費 3,000円

※初年度は年会費無料

2. 登壇申込

**6月27日(火)
17:00締切**

締切以降の取消、差し替え、修正は一切受け付けておりませんのでご注意ください。

3. 参加申込

※2016年秋に価格改定しました

事前予約

正会員 12,000円
学生 3,000円
シニア会員 4,000円
非会員 23,000円

当日受付

正会員 18,000円
学生 5,000円
シニア会員 7,000円
非会員 30,000円

以下の常設の大分類、中分類および合同セッション、シンポジウムで一般講演を募集します。講演日・講演分科は7月3日(月)のプログラム編集委員会にて決定し、7月下旬に皆様にお伝えします。

大分類分科名 Category	中分類分科名	Section
1 応用物理学一般 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology	1.1 応用物理一般・学際領域	Interdisciplinary and General Physics
	1.2 教育	Education
	1.3 新技術・複合新領域	Novel technologies and interdisciplinary engineering
	1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	Energy conversion, storage, resources and environment
	1.5 計測技術・計測標準	Instrumentation, measurement and Metrology
	1.6 超音波	Ultrasonics
2 放射線 Ionizing Radiation	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	Radiation physics and Detector fundamentals
	2.2 検出器開発	Detection systems
	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	Application, radiation generators, new technology
3 光・フォトニクス Optics and Photonics	3.1 光学基礎・光学新領域	Basic optics and frontier of optics
	3.2 材料・機器光学	Equipment optics and materials
	3.3 情報フォトニクス・画像工学	Information photonics and image engineering
	3.4 生体・医用光学	Biomedical optics
	3.5 レーザー装置・材料	Laser system and materials
	3.6 超高速・高強度レーザー	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers
	3.7 レーザープロセス	Laser processing
	3.8 光計測技術・機器	Optical measurement, instrumentation, and sensor
	3.9 テラヘルツ全般	Terahertz technologies
	3.10 光子物理学・技術	Optical quantum physics and technologies
	3.11 フォトニック構造・現象	Photonic structures and phenomena
	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	Nanoscale optical science and near-field optics
	3.13 半導体光デバイス	Semiconductor optical devices
	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	Optical control devices and optical fibers
	3.15 シリコンフォトニクス	Silicon photonics
4 JSAP-OSA Joint Symposia すべてEnglish Session	4.1 Plasmonics	Plasmonics
	4.2 Bio- and Medical Photonics	Bio- and Medical Photonics
	4.3 Nano- and Micro-Photonics	Nano- and Micro-Photonics
	4.4 Opto-electronics	Opto-electronics
	4.5 Information Photonics	Information Photonics
	4.6 Nanocarbon and 2D Materials	Nanocarbon and 2D Materials
	4.7 Terahertz Photonics	Terahertz Photonics
	4.8 Strong Light Excitation Phenomena Applied to Materials and Bio Engineering	Strong Light Excitation Phenomena Applied to Materials and Bio Engineering
	4.9 Quantum Optics	Quantum Optics
6 薄膜・表面 Thin Films and Surfaces	6.1 強誘電体薄膜	Ferroelectric thin films
	6.2 カーボン系薄膜	Carbon-based thin films
	6.3 酸化物エレクトロニクス	Oxide electronics
	6.4 薄膜新材料	Thin films and New materials
	6.5 表面物理・真空	Surface Physics, Vacuum
	6.6 フロー顕微鏡	Probe Microscopy
7 ビーム応用 Beam Technology and Nanofabrication	7.1 X線技術	X-ray technologies
	7.2 電子ビーム応用	Applications and technologies of electron beams
	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	Micro/Nano patterning and fabrication
	7.4 量子ビーム界面構造計測	Buried interface sciences with quantum beam
	7.5 イオンビーム一般	Ion beams
	7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術	Atomic/molecular beams and beam-related new technologies
8 プラズマエレクトロニクス Plasma Electronics	8.1 プラズマ生成・制御	Plasma production and control
	8.2 プラズマ診断・計測	Plasma measurements and diagnostics
	8.3 プラズマ成膜・表面処理	deposition of thin film and surface treatment
	8.4 プラズマエッチング	Plasma etching
	8.5 プラズマナノテクノロジー	nanotechnology.
	8.6 プラズマライフサイエンス	Plasma life sciences
	8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野	Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications
	8.8 Plasma Electronics English Session	Plasma Electronics English Session
9 応用物性 Applied Materials Science	9.1 誘電材料・誘電体	Dielectrics, ferroelectrics
	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	Nanowires and Nanoparticles
	9.3 ナノエレクトロニクス	Nanoelectronics
	9.4 熱電変換	Thermoelectric conversion
	9.5 新機能材料・新物性	New functional materials and new phenomena
10 スピントロニクス・マグネティクス Spintronics and Magnetism	10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	Emerging materials in spintronics and magnetism (including fabrication and characterization technologies)
	10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	Fundamental and exploratory device technologies for spin
	10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術	Spin devices, magnetic memories and storages
	10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	Semiconductor spintronics, superconductor, multiferroics
	10.5 磁場応用	Application of magnetic field
11 超伝導 Superconductivity	11.1 基礎物性	Fundamental properties
	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth
	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	Critical Current, Superconducting Power Applications
	11.4 アナログ応用および関連技術	Analog applications and their related technologies
	11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	Junction and circuit fabrication process, digital applications

大分類分科名 Category	中分類分科名	Section
12 有機分子・バイオエレクトロニクス Organic Molecules and Bioelectronics	12.1 作製・構造制御	Fabrications and Structure Controls
	12.2 評価・基礎物性	Characterization and Materials Physics
	12.3 機能材料・萌芽のデバイス	Functional Materials and Novel Devices
	12.4 有機EL・トランジスタ	Organic light-emitting devices and organic transistors
	12.5 有機太陽電池	Organic solar cells
	12.6 ナノバイオテクノロジー	Nanobiotechnology
	12.7 医用工学・バイオチップ	Biomedical Engineering and Biochips
13 半導体 Semiconductors	13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials
	13.2 探索的材料物性・基礎物性	Exploratory Materials, Physical Properties, Devices
	13.3 絶縁膜技術	Insulator technology
	13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	Si wafer processing /Si based thin film /MEMS/Integration technology
	13.5 デバイス/集積化技術	Semiconductor devices and related technologies
	13.6 Semiconductor English Session	Semiconductor English Session
	13.7 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	Nanostructures, quantum phenomena, and nano quantum devices
	13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	Compound and power electron devices and process technology
	13.9 光物性・発光デバイス	Optical properties and light-emitting devices
	13.10 化合物太陽電池	Compound solar cells
15 結晶工学 Crystal Engineering	15.1 バルク結晶成長	Bulk crystal growth
	15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	II-VI and related compounds
	15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	III-V-group epitaxial crystals/Fundamentals of epitaxy
	15.4 III-V族窒化物結晶	III-V-group nitride crystals
	15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶	Group IV crystals and alloys
	15.6 IV族系化合物 (SiC)	Group IV Compound Semiconductors (SiC)
	15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	Crystal evaluation, impurities and crystal defects
16 非晶質・微結晶 Amorphous and Microcrystalline Materials	16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	Fundamental properties, evaluation, process and devices in disordered materials
	16.2 エナジーハーベスティング	Energy Harvesting
	16.3 シリコン系太陽電池	Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells
17 ナノカーボン Nanocarbon Technology	17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料	Carbon nanotubes & other nanocarbon materials
	17.2 グラフェン	Graphene
	17.3 層状物質	Layered materials
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」 Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"	薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス, 6.4薄膜新材料, および結晶工学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです。	This is a joint session of 6.3 Oxide-based electronics, 6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering.
合同セッションM 「フォノンエンジニアリング」 Joint Session M "Phonon Engineering"	9.4熱電変換, 13.7ナノ構造・量子現象, 17ナノカーボンで企画した合同セッションです。	This is a joint session of 9.4 Thermoelectric conversion, 13.7 Nano structures and quantum phenomena and 17 Nanocarbon Technology.

●分科企画シンポジウム

開催日	大分類名 シンポジウム名
9/5 (火)	1.応用物理学一般 科学技術の人育成および教育の取組みとその活性化 -九州地区-
	3.光・フォトニク フォトニクスにおける極限計測技術
	6.薄膜・表面 材料ナノテクノロジー：薄膜とナノ複合体の表面と界面
	13.半導体 新物質/量子構造に基づく発光デバイス研究の最前線と展望
	15.結晶工学 シリコン結晶における不純物制御の科学 ～ゲタリングが描くウェーハの未来像～
	2.放射線 国際リアコライダー計画とその技術
9/6 (水)	3.光・フォトニク ハイブリッド量子系における電磁界制御
	6.薄膜・表面 酸化物のテラヘルツ光物性とデバイス応用への展望
	6.薄膜・表面 13.半導体 新デバイス・材料開発のためのナノスケール3次元分析 (I)
	8.プラズマエレクトロニクス 先進農業に向けたプラズマ応用最前線 ～新たな植物生育環境の開発・制御～
	10.スピントロニクス磁ネティクス 光とスピンが織りなす研究の最前線

●分科企画シンポジウム

開催日	大分類名
	シンポジウム名
9/7 (水)	12.有機分子・バイオエレクトロニクス 萌芽的デバイスとしての有機センサー-IoT時代に向けて-
	12.有機分子・バイオエレクトロニクス 最新動向：生体材料と先端デバイスをつなぐ学際的アプローチ
	13.半導体 マルチスケールプロセスへの挑戦～ドライカウエットかそれとも…～
	13.半導体 I V族半導体の製膜と低温結晶化（固相結晶化を中心に）
	13.半導体 GFIS（電界電離ガスイオン源）・先端イオン源顕微鏡技術とその材料・デバイス研究開発への応用
	15.結晶工学 転位研究の最前線 ～材料を越えた視点から見えてくるもの～
	15.結晶工学 革新デバイスを支えるIII-V族半導体の成長技術
9/8 (金)	合同セッションK これからの未来を担う新ワイドギャップ酸化物材料Ga2O3

●公募シンポジウム

9/5 (火)	12.有機分子・バイオエレクトロニクス フレキシブル環境発電デバイスの新展開
	13.半導体 多元系化合物・太陽電池のこれまでとこれから -多元系化合物・太陽電池研究会30周年記念シンポジウム-

参加申込(8月16日(水)締切)

2016年秋季講演会より参加費を改定させていただきました。

【正会員(不課税)】	予約	12,000円	当日	18,000円
【学生(不課税)】	予約	3,000円	当日	5,000円
【シニア会員 ^(*) (不課税)】	予約	4,000円	当日	7,000円
【協定学会 ^(**) 会員(不課税)】	予約	12,000円	当日	18,000円
【非会員 ^(***) (税込)】	予約	23,000円	当日	30,000円

(*)常勤として勤務に就かれていない60歳以上の会員。一般会員からの種別変更が必要です。

(**)協定学会：APS(American Physical Society), CSOE(Chinese Society for Optical Engineering), EOS(European Optical Society), EPS(European Physical Society), IOP(Institute of Physics), KPS(Korean Physical Society), OSA(Optical Society of America), OSK(Optical Society of Korea), PESJ(日本物理教育学会), PSROC(The Physical Society of Republic of China), SFP(Société Française de Physique), SPIE(International Society for Optical Engineering), TPS(Taiwan Photonics Society)

(***)ご所属先が賛助会員であっても、参加者本人が個人会員でない場合は非会員扱いとなります。